

Сведения об официальном оппоненте

по диссертации Скорнякова Станислава Петровича

на тему: «Низковольтные диффузионные p-n-переходы с туннельным и смешанным механизмами пробоя в технике полупроводниковых приборов»

по специальности 2.2.2. - «Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств»

на соискание ученой степени доктора технических наук

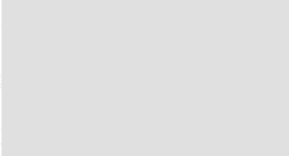
Ф.И.О. полностью	Петросянц Константин Орестович
Гражданство	РФ
Ученая степень	Доктор технических наук
Шифр и название специальности по которой защищена диссертация оппонента, отрасль науки	Специальность (05.27.01) Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нано-электроника, приборы на квантовых эффектах
Ученое звание	Профессор
Основное место работы:	
Полное наименование организации в соответствии с уставом	Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики
Сокращенное наименование организации	МИЭМ НИУ ВШЭ
Ведомственная принадлежность организации	Министерство науки и высшего образования РФ
Почтовый адрес организации	123458, г. Москва, ул. Таллинская, д. 34.
Телефон, факс, e-mail организации	Телефон, факс 8 (495) 916-88-29, +7 (495) 772-95-90, доб. 15208. E-mail: miem@hse.ru, kpetrosyants@hse.ru
Наименование подразделения организации	Департамент электронной инженерии
Должность в организации	Профессор-исследователь

Список основных публикаций по теме оппонируемой диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций):

1.	Petrosyants K. O., Popov D. Self-Heating Investigation in SOI MOSFET Structures with High Thermal Conductivity Buried Insulator Layers //2020, 36th Semiconductor Thermal Measurement, Modeling & Management Symposium (SEMI-THERM). San Jose, CA USA: IEEE, 2020. P. 56-60.
2.	Petrosyants K. O., Popov D. Comparison of Self-heating Effect in SOI MOSFETs with Various Configuration of Buried Oxide //Proc. of the 2nd International Conference on Microelectronic Devices and Technologies (MicDAT '2019). Barcelona: International Frequency Sensor Association (IFSA), 2019. P. 24-28.
3.	Adonin A. S., Petrosyants K. O., Popov D. Modeling of the Submicron MOSFETs Characteristics for UTSi Technology // Proceedings of SPIE. 2019. Vol. 11022. P. 1-6.
4.	Petrosyants K. O., Pugachev A. A., Kharitonov I. A. Universal physical model of low-power and long lifetime betavoltaic microbatteries // Proceedings of the Seventh European Conference on Renewable Energy Systems (ECRES2019). Madrid , 2019. P. 1-7.
5.	Konstantin O. Petrosyants, Nikita I. Ryabov. Quasi-3D Thermal Simulation of Multi-Chip Stack Embedding Package, // 2020, 26th International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems (THERMINIC). IEEE, 2020. P. 1-7.
6.	Петросянц К. О., Харитонов И. А., Пугачев А. А. Расчет ВАХ бетавольтаических микробатарей с использованием универсальной TCAD модели // Наноиндустрия. Специальный выпуск: Международный форум "Микроэлектроника-2019". 5-я Международная научная конференция "Электронная компонентная база и микроэлектронные модули" Т. 1. Вып. 96. Рекламно-издательский центр "ТЕХНОСФЕРА", 2020. С. 291-294.
7.	Лебедев С. В., Петросянц К. О., Стахин В. Г., Харитонов И. А. Особенности моделирования субмикронных МОП-транзисторов для расчета низковольтных и микроощных КМОП СБИС // Наноиндустрия. 2018. № 82. С. 412-414.
8.	Петросянц К.О., Попов Д.А. Моделирование эффекта саморазогрева КНИ МОП-транзистора с различной конфигурацией скрытого оксида // Известия высших учебных заведений. Электроника. 2018. Т. 23. № 5. С. 521-525.
9.	Петросянц К.О., Попов Д.А., Быков Д.В. TCAD-моделирование дозовых радиационных эффектов в суб-100-нм high-k МОП-транзисторных структурах // Известия высших учебных заведений. Электроника. 2017. Т. 22. № 6. С. 569-581.
10.	Petrosyants K.O., Kozhukov M.V. Physical TCAD model for proton radiation effects in SiGe HBTs // IEEE Transactions of Nuclear Science. 2016. V. 63. № 4. P. 2016-2021.
11.	Петросянц К.О., Самбурский Л.М., Харитонов И.А., Кожухов М.В.

	Измерения электрических характеристик биполярных и МОП-транзисторов под действием радиации // Измерительная техника. 2016. № 10. С. 55-60.
12.	Petrosyants K. O., Kharitonov I. A., Lebedev S. V., Sambursky L. M., Safonov S. O., Stakhin V. G. Electrical characterization and reliability of submicron SOI CMOS technology in the extended temperature range (to 300 °C) // Microelectronics and Reliability. 2017. Vol. 79. P. 416-425.

«14» сентября 2021 г.

 Константин Орестович Петросянц

Сведения (подпись) Петросянца К.О. заверяю.

Подпись заверяю

Печать

 РОВАНИЮ